

GC6420H 可编程 64 位锁存器控制模拟开关

፟ 概述

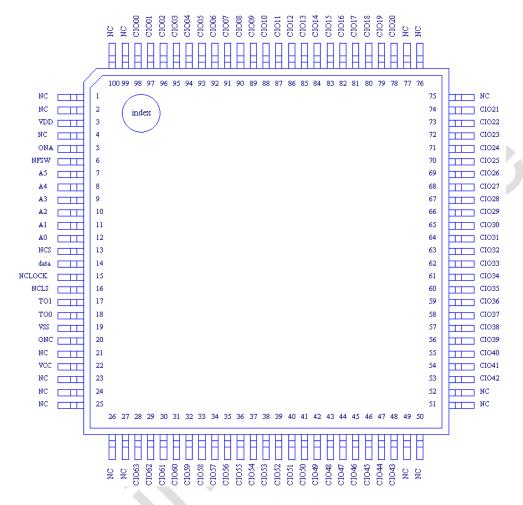
GC6420H可编程 64 位锁存器控制模拟开关是用硅栅 CMOS 工艺制造的单片集成电路,在控制信号 data、NCLS、NCS、NCLOCK、NFSW 和地址信号 A0 - A5 控制下,可方便地改变或保持 64 个锁存器的状态,每一个锁存器的状态控制对应的一个"单刀双掷"模拟开关的通断状态,从而可方便地用于 PCB 光板高压测试机的控制逻辑电路中。

⋋ 特点

- ◆ 符合 MIL-STD-883E MOTHED 3015.7标准,电路所有 I/O 管脚 ESD≥±8KV。
 MIL-STD-883E MOTHED 3015.7标准的认定:放电电阻:1.5KΩ,储能电容:100PF。
- ◆ 锁存器的状态改变或保持方便
- ◆ 片选 NCS 可视同高位地址信号,便于扩展多片应用
- ◆ 控制信号 data、NCLS、NCS、NCLOCK、NFSW、地址信号 A0 A5、输出信号 TO0、TO1 与 TTL 电平兼容。
 - ◆ ±5V 供电,模拟开关通道可通过±4V 之间电位,方便使用。
 - ◆ 工作速度快,输出控制信号频率可≤1MHz。
 - ◆ LQFP-100 Pin 封装。



№ 管脚图



LQFP100 封装管脚图

🖎 管脚说明

管脚名称	管脚功能		
CI000 - CI063	模拟开关输出节点。输出端。外接 NPN 或 PNP 晶体管不需		
	基极电阻,基极电阻已做在模拟开关电路内部。		
ONA	模拟开关一个输入节点,输入端。		
ONC	模拟开关另一个输入节点,输入端。		
A0 - A5	地址信号输入端,与 NCS 配合,选择 64 个锁存器。		
NCS	片选信号输入端,NCS=0 有效。		
NCLS	锁存器清"0" 信号输入端, NCLS=0 有效。		
data	锁存器数据输入端。		
NCLOCK	锁存器时钟信号输入端。在地址选中情况下,NCLOCK=0,		
	data 打入锁存器; NCLOCK=1, 锁存器保持数据不变。		
NFSW	输入端。迫使选中地址对应的模拟开关 CIOxx 与 ONC 导通。		
T00、T01	OC 门输出端。使用时外接 4.7KΩ 电阻到 VDD (+5V)。用		
	于检测选中地址锁存器的状态。		



VDD (+5V)	正电源。VDD = + 5V
VCC (-5V)	负电源。VCC = - 5V
VSS	地线。
NC	空脚

🖎 工作模式

	模式条件				
工作模式	NFSW	NCLS	NCS	NCLOCK	操作内容
Mode1	1	1	0	0	写一个数据 data 到地址单元指定
写一个数据到					的锁存器:
地址单元指定					Data=0, CI0xx 与 ONC 导通。
的锁存器,其余					Data=1, CIOxx 与 ONA 导通。
锁存器保持数					没选中地址单元对应的锁存器保
据不变。					持原数据不变。
Mode2	1	1	0	1	锁存器保持原数据不变。
锁存器保持原	1	1	1	0	
数据不变。					
Mode3	1	0	0	0	写一个数据 data 到地址单元指定的
写一个数据到					锁存器:
地址单元指定					Data=0, CI0xx 与 ONC 导通。
的锁存器,其余					Data=1,CIOxx 与 ONA 导通。
锁存器清"0"。					没选中地址单元对应的锁存器清
	\			>	"0",没选中地址对应的模拟开关
					CIOxx 全部与 ONC 导通。
Mode4	1	0	1	0	64个锁存器全部清"0",即所有64
所有地址单元	1	0	0	1	个地址单元对应的模拟开关 CIOxx 全
锁存器清"0"。					部与 ONC 导通。
Mode5	1	1	0	1	读选中地址单元对应的锁存器状态。
读选中地址单					锁存器为"1",TO0=0,TO1=1;锁
元对应的锁存					存器为 "0", TO0 = 1, TO1 = 0。NCS =
器状态。					1, TO0 = 1, TO1 = 1。读锁存器状态不
					改变锁存器内容,全部锁存器状态保持
					原数据不变。
Mode6	0	1	0	1	Force 选中地址单元对应的模拟开
Force 选中地					关 CIOxx 与 ONC 导通。
址单元对应的					Force 不改变锁存器内容。
模拟开关					
CIOxx与ONC导					
通。					



☒ 极限参数

参数	最小	典型	最大	单位	测试条件
正工作电压 VDD	0	5. 0	6.0	V	
负工作电压 VCC	-6.0	-5.0	0	V	
电路总功耗			500	mW	
工作温度	-10	20	70	$^{\circ}$	
储存温度	-55		150	$^{\circ}$	
ESD	±2	±3	±4	KV	

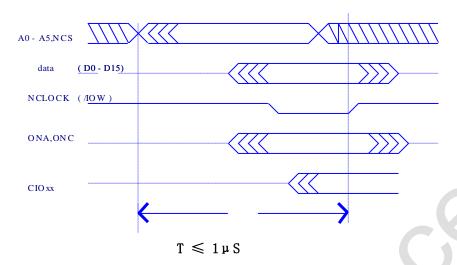
主要电气参数(T=25℃, VDD=+5V, -VDD=-5V)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
正电源电压	VDD	4. 5	5. 0	5. 5	V	
负电源电压	VCC	-5. 5	-5.0	-4.5	V	
正电源电流	IDD		3	5	mA	ONA、ONC、CIOxx 悬空。
负电源电流	-IDD	-5	-3		mA	ONA、ONC、CIOxx 悬空。
输入低电平电压	ViL			0.8	V	VDD=+5V,VDD=-5V
输入高电平电压	ViH	3. 2			V	VDD=+5V, -VDD=-5V
单个模拟开关导	Ron	200		500	Ω	Ion =1.5 mA,
通电阻						VDD=+5V, -VDD=-5V
单个模拟开关导	Ion		1.5	2.0	mA	模拟开关通道电压:
通电流						-4V - +4V
单个模拟开关关	Ioff			0. 1	μА	模拟开关通道电压:
断电流						-4V - +4V
控制信号工作频	Fmin	1			MHz	VDD=+5V, -VDD=-5V
率						

🖎 Timing 时序 图

GC6420H 是一个挂在 ISA 总线上工作的接口电路, 地址 AO - A5、片选 NCS、数据 data(Di)、NCLOCK(/IOW)信号符合 ISA 总线 Timing 时序。

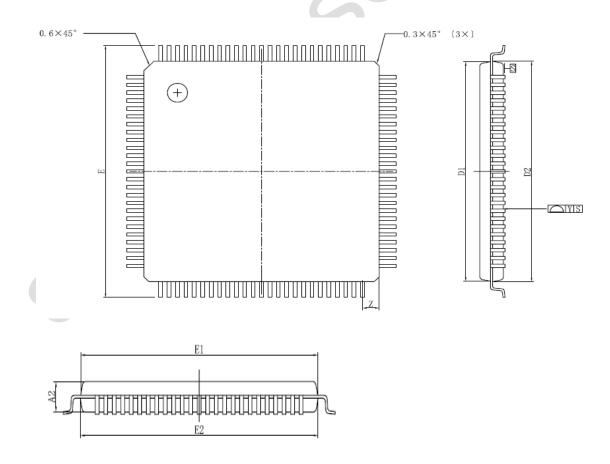




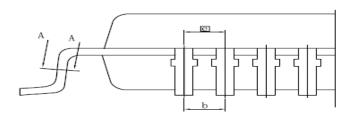
⋈ 应用注意事项

- 1、GC6420H 的应用要遵守 74HC 系列通用 CMOS 电路技术规范。
- 2、为了提高电路抗干扰能力,应在 GC6420H 电路的 ONA、ONC 分别串接一个 200 欧姆电阻。VDD、-VDD 应分别加 **0.1uF** 滤波电容。
- 3、模拟开关导通电阻 200 500 欧姆,导通电流 1 1.5mA,过大电流会烧坏电路。

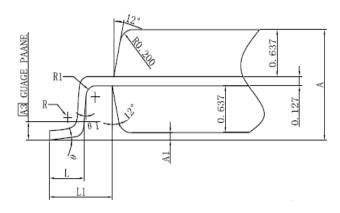
≥ 封装尺寸图







DAMBAR REST SCALE 4:1



symbol	Min	Nom	Max
A	1.45	1. 55	1.65
A1	0. 01	_	0. 21
A2	1.3	1.4	1.5
A3	_	0. 254	
b	0.15	0.20	0. 25
b1	0.16	0. 22	0.28
С	_	0. 127	_
D1	13.85	13.95	14.05
D2	13. 9	14.00	14. 10
E	15.8	16.00	16. 20
E1	13.85	13.95	14.05
E2	13.9	14.00	14. 10
е	_	0.5	_
L	0.42	-	0.72
L1	0.95	1.0	1. 15
R	0.1	_	0. 25
R1	0.1	_	_
θ	0	-	10°
9 1	0	_	_
у	_	_	0.1
Z	_	1.0	

ຆ 订货信息

产品型号	供货方式
GC6420H	LQFP100 封装片,每盘 90 片

🕦 文档修改记录

版本	更改内容 (每行一项)	更改日期&更改者(简写)
V10	发行	20190510 by wyq

🥦 文档信息

◆ 创建日期: 2019-5-10